

## PIN 结 Si 光电二极管

### 描述

工作在低频区域的 Si 光电二极管,可探测波长处于峰值波长附近的光信号。

### 应用

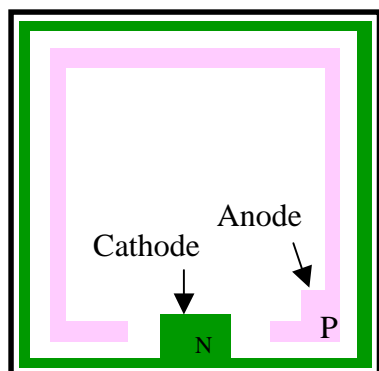
- 遥控电路
- 光纤通信

### 结构

芯片结构: 平面 PIN 型结构

电极: 顶部 AlSi

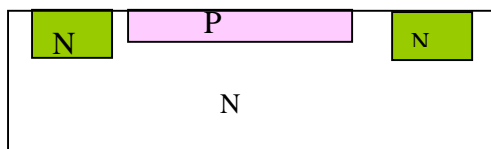
### 外形图和尺寸



芯片尺寸: 1.6 mm × 1.6 mm

芯片厚度: 300±25μm

### 纵向结构



芯片结构: 平面 PIN 型结构

电极: AlSi

**光电特性** ( $T_a=25^\circ$  )

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
暗电流 Reverse dark current	$I_D$	$V_R=10V$ $E=0mW/cm^2$			30	nA
反向击穿电压 Reverse breakdown voltage	$V_{BR}$	$I_R=100\mu A$ , $H=0mV/cm^2$	60	100		V
开路电压 Open circuit voltage	$V_{OC}$	$E=5mW/cm^2$		400		mV
短路电流 Short circuit current	$I_{OC}$	$E=5mW/cm^2$		20		$\mu A$
光电流 Reverse light current	$I_L$	$V_R=5V$ $E=5mW/cm^2$		20		$\mu A$
总电容 Total capacitance	$C_T$	$V_R=5V$ $E=0mW/cm^2$ $f=1MHz$		7		pF

**典型曲线**

- 光谱响应

